

【 支援装置料金表 <微細加工> 】 2019年10月1日改定
 北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室 <<http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/>>

装置名	型式	初回講習料 (円)	利用料 (円/1h) (学外者(大 学・公的機 関))	利用料 (円/1h) (学外者(一 般))	技術補助料 (円/1h) (学外者(大 学・公的機 関))	技術補助料 (円/1h) (学外者(一 般))	技術代行料 (円/1h) (学外者(大 学・公的機 関))	技術代行料 (円/1h) (学外者(一 般))
超高精度電子ビーム描画装置 125kV	ELS-F125-U	35,200	2,800	7,900	7,200	12,300	11,600	16,700
超高精度電子ビーム描画装置 100kV	ELS-7000HM	35,200	1,800	6,800	6,200	11,200	10,600	15,600
マスクアライナ	MA-20	13,200	800	1,500	5,200	5,900	9,600	10,300
レーザー描画装置	DDB-201-200	22,000	900	3,300	5,300	7,700	9,700	12,100
真空蒸着装置	ED-1500R	22,000	800	1,500	5,200	5,900	9,600	10,300
プラズマCVD装置	PD-220ESN	22,000	1,300	4,400	5,700	8,800	10,100	13,200
液体ソースプラズマCVD装置	PD-10C1	22,000	300	400	4,700	4,800	9,100	9,200
ヘリコンスパッタリング装置	MPS-4000C1/HC1	13,200	2,200	3,600	6,600	8,000	11,000	12,400
イオンビームスパッタ装置	IBS-6000S	13,200	1,500	2,100	5,900	6,500	10,300	10,900
原子層堆積装置	SUNALE-R	13,200	2,500	5,000	6,900	9,400	11,300	13,800
ICPドライエッチング装置	SPM-200	22,000	1,500	4,100	5,900	8,500	10,300	12,900
反応性イオンエッチング装置	RIE-101iPH	13,200	2,100	4,400	6,500	8,800	10,900	13,200
反応性イオンエッチング装置	RIE-10NRV	13,200	1,400	3,400	5,800	7,800	10,200	12,200
ドライエッチング装置	NLD-500	13,200	1,200	1,900	5,600	6,300	10,000	10,700
イオンミリング装置	IBE-6000S	13,200	600	1,000	5,000	5,400	9,400	9,800
電界放射型走査型電子顕微鏡	JSM-6700FT	22,000	900	1,000	5,300	5,400	9,700	9,800
電子ビーム描画装置	ELS-3700	26,400	1,500	2,300	5,900	6,700	10,300	11,100
電子線描画装置	ELS-7300	70,400	1,800	5,500	6,200	9,900	10,600	14,300
両面マスクアライナ	MA-6	70,400	700	2,900	5,100	7,300	9,500	11,700
ECR加工装置	EIS-200ER	44,000	1,000	1,600	5,400	6,000	9,800	10,400
ICP加工装置	EIS-700S	26,400	1,100	1,100	5,500	5,500	9,900	9,900
超高真空5源ヘリコンスパッタ	Av028	26,400	1,300	2,500	5,700	6,900	10,100	11,300
ALD製膜装置	Savannah 100	26,400	1,600	3,000	6,000	7,400	10,400	11,800
スパッタ装置	SPF-210H	26,400	300	500	4,700	4,900	9,100	9,300
EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	EBX-8C	17,600	2,500	2,900	6,900	7,300	11,300	11,700
EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	AV096-000	17,600	1,400	2,600	5,800	7,000	10,200	11,400
FIB加工装置	EIP-3300	44,000	1,600	2,100	6,000	6,500	10,400	10,900
ナノカーボン成長炉	Easy tube system	44,000	400	400	4,800	4,800	9,200	9,200
エリブソメーター	M-500S	8,800	200	700	4,600	5,100	9,000	9,500
超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	ELS-F130HM	35,200	6,100	28,100	10,500	32,500	14,900	36,900
半導体薄膜堆積装置	PAC-LMBE	35,200	1,900	5,700	6,300	10,100	10,700	14,500
電子線三次元粗さ解析装置	ERA-8000FE	35,200	1,300	1,300	5,700	5,700	10,100	10,100
コンパクトスパッタ装置	ACS-4000-C3-HS	13,200	1,700	3,700	6,100	8,100	10,500	12,500
ICP高密度プラズマエッチング装置	RIE-101iHS	13,200	1,700	6,000	6,100	10,400	10,500	14,800
スパッタ装置	SSP3000Plus	105,600	800	1,800	5,200	6,200	9,600	10,600
ダイシングソー	DAD322	105,600	800	1,200	5,200	5,600	9,600	10,000

技術支援料(サンプル前処理・設計等)

4,400円/時間

(ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業その他の難易度の高い作業を伴う場合にあっては8,800円)

技相談料

11,000円/時間